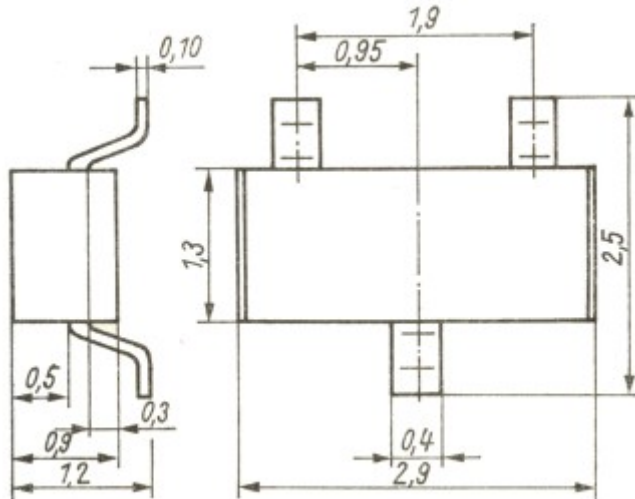


RFT SCE237 – SCE238 - SCE239

Silizium- npn- Epitaxie- Planar- Transistoren für den universellen Einsatz in der NF- Technik.
Für den Einsatz in verkapselten Hybridschaltkreisen vorgesehen



Wärmewiderstand R_{thja}
auf Glassubstrat 7x7x1mm $\leq 0,7K/mW$
auf Keramik 30x12x1mm $\leq 0,45K/mW$

Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

	SCE238	SCE239	SCE237
U_{CBO} =	30V	30V	50V
U_{CEO} =	20V	20V	45V
U_{EBO} =	5V	5V	5V
I_C =		100mA	
P_{tot} = (bei $\vartheta_a = 45^\circ C$)		150mW	
ϑ_{jmax} =		+150°C	
ϑ_a =		-55 ... +125°C	

RFT SCE237 – SCE238 - SCE239

Statische Kennwerte (bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} -5\text{K}$)

I_{CBO}	(bei $U_{\text{CB}} = 30\text{V}$)	SCE238, SCE239	\leq	100nA
I_{CBO}	(bei $U_{\text{CB}} = 50\text{V}$)	SCE237	\leq	100nA
$U_{(\text{BR})\text{CEO}}$	(bei $I_{\text{C}} = 10\text{mA}$)	SCE238, SCE239	\geq	20V
		SCE237	\geq	45V
U_{CEsat}	(bei $I_{\text{C}} = 100\text{mA}$, $I_{\text{B}} = 5\text{mA}$) ¹⁾		typ.	220mV
$h_{21\text{E}}$	(bei $U_{\text{CE}} = 6\text{V}$, $I_{\text{C}} = 2\text{mA}$)	Gruppe d		112-280
		Gruppe e		224-560
		Gruppe f		450-1120

¹⁾ Impulsmässige Messung

Dynamische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} -5\text{K}$)

f_{T}	(bei $U_{\text{CE}} = 6\text{V}$, $I_{\text{C}} = 10\text{mA}$, $f = 20\text{MHz}$)	$h_{21\text{e}}$	Gruppe d	typ.	185MHz
			e	typ.	210MHz
			f	typ.	265MHz
F	(bei $U_{\text{CE}} = 6\text{V}$, $I_{\text{C}} = 0,2\text{mA}$, $f=1\text{kHz}$)				
Δf	$= 100\text{Hz}$, $R_{\text{G}} = 2\text{k}\Omega$)	SCE237, SCE238	\leq	10dB	
F	(bei $U_{\text{CE}} = 6\text{V}$, $I_{\text{C}} = 0,2\text{mA}$, $R_{\text{G}} = 2\text{k}\Omega$)				
f	$= 0,03 \dots 15\text{kHz}$	SCE239	\leq	4dB	

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985